

2SB851
2SB1278

エピタキシャルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ
中電力増幅用/Medium Power Amp.
Epitaxial Planar PNP Silicon Transistors

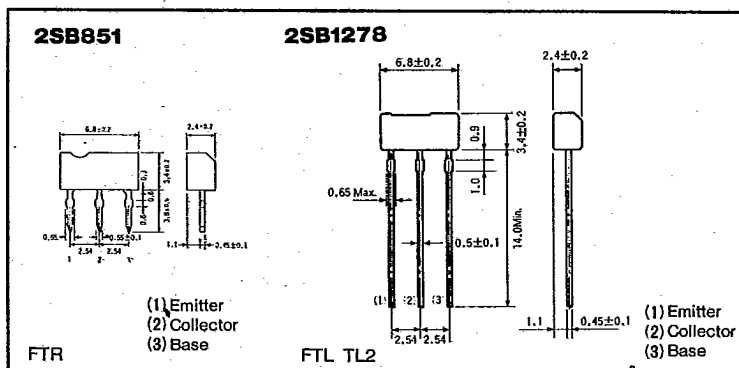
● 特長

- 1) 小型FTRパッケージにて $P_C=750\text{mW}$ である。
- 2) $V_{CE0}=-80\text{V}$ と高耐圧である。

● Features

- 1) Compact FTR package delivering high power:
 $P_C=750\text{mW}$
- 2) High breakdown voltage:
 $V_{CEO}=-80\text{V}$

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



注：FTLの外形仕様については、TL3/4タイプも用意しています（p.38参照）。

● 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-700	mA
コレクタ損失	P_C	750	mW
接合部温度	T_J	150	°C
保存温度範囲	T_{stg}	-55~150	°C

● 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	V_{CEO}	-80	—	—	V	$I_C = -2\text{mA}$
コレクタ・ベース降伏電圧	V_{CBO}	-80	—	—	V	$I_C = -50\mu\text{A}$
エミッタ・ベース降伏電圧	V_{EBO}	-5	—	—	V	$I_E = -50\mu\text{A}$
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	—	—	-0.5	μA	$V_{CB} = -50\text{V}$
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	—	—	-0.5	μA	$V_{EB} = -4\text{V}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	-0.2	-0.4	V	$I_C/I_B = -500\text{mA}/-50\text{mA}$
直流電流増幅率	h_{FE}	82	—	390	—	$V_{CE}/I_C = -3\text{V}/-100\text{mA}$
利得帯域幅積 (トランジション周波数)	f_T	—	100	—	MHz	$V_{CE} = -10\text{V}, I_E = 50\text{mA}$
出力容量	C_{ob}	—	14	20	pF	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$

h_{FE} の値により下表のように分類します。

Item	P	Q	R
h _{FE}	82~180	120~270	180~390

● 標準品・準標準品一覽表

(◎:標準品 ○:準標準品)

Type	hFE	包装名	バルク	エテナ	テーピング	
		記号		C1	TL2	TL3
		基本発注単位(個)	1 000	4 000	2 500	2 500
2SB851	PQR		◎	○	○	—
2SB1278	PQR		—	—	○	○

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

T-27-15

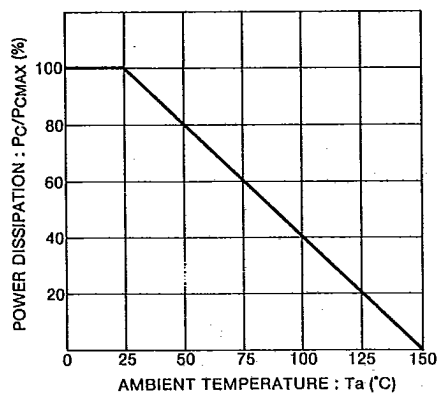


Fig.1 電力軽減曲線

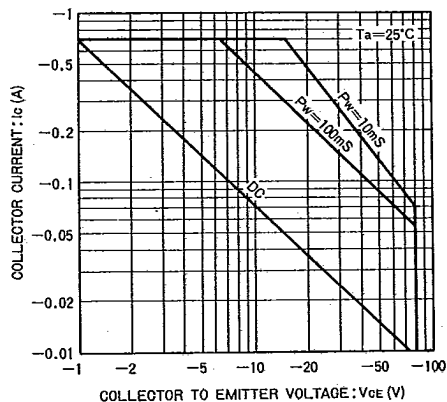


Fig.2 安全動作領域

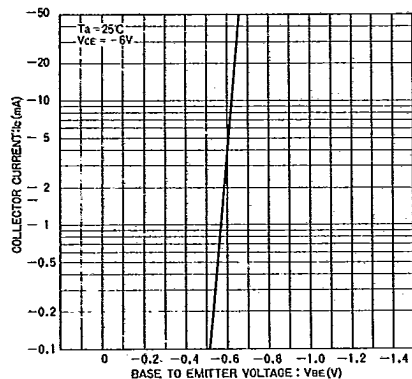


Fig.3 エミッタ接地伝達静特性

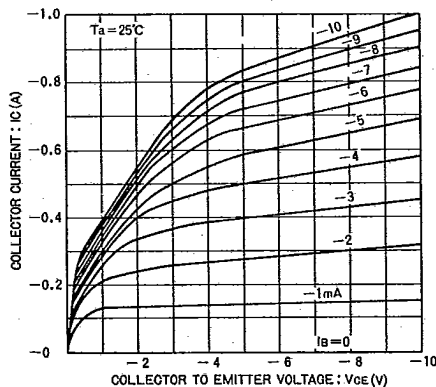


Fig.4 エミッタ接地出力静特性

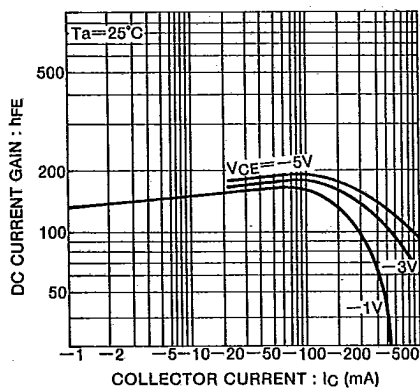


Fig.5 直流電流増幅率—コレクタ電流特性

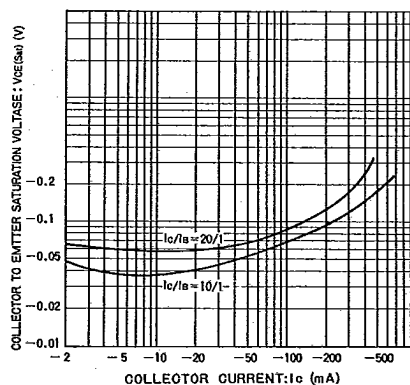


Fig.6 コレクタ・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性

トランジスタ
2SBタイプ

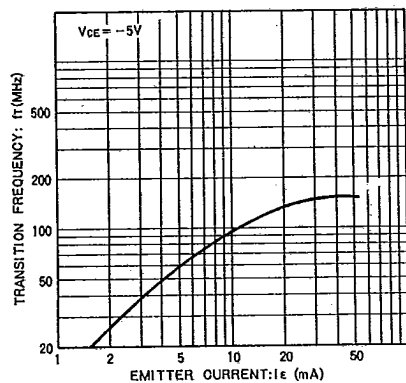
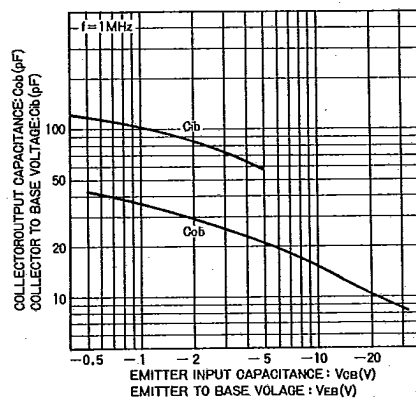


Fig.7 利得帯域幅積—エミッタ電流特性

Fig.8 コレクタ出力容量—コレクタ・ベース電圧特性
エミッタ入力容量—エミッタ・ベース電圧特性